

ISPlasma2010
第2回先進プラズマ科学と窒化物及びナノ材料への応用に関する
国際シンポジウムプログラム

3/7(日)	3/8(月)			3/9(火)			3/10(水)												
	受付 (8:30-19:00)			受付 (9:00-18:00)			受付 (9:00-17:00)												
<p>開会式：吉村特別講演(ASCTF)</p> <p>9:20-9:35 開会の辞 ・小松 弥生 (文部科学省科学技術学術政策局 科学技術学術総括官) ・加藤 伸一 (東海広域知的クラスター創成事業本部 本部長) ・堀 勝 (名古屋大学)</p> <p>9:35-9:45 大塚美則 (財団法人科学技術交流財団) "Tokai Region Nanotechnology Manufacturing Cluster and its Expansion Program"</p> <p>9:45-10:15 Plenary Lecture 8a-A01S 飯島 澄男 (名城大学) "Structural Characterization of Nano-carbon Materials on the Atomic Resolution Basis"</p>	<p>9:20-9:50 基調講演 9a-A01KA M. Goeckner (テキサス大学ダラス校, アメリカ) "Energy Considerations in Plasma-surface Interactions"</p> <p>9:50-10:10 9a-A02OA S. Barnola (CEA-LETI-MINATEC) "Challenges in Plasma Etching of Narrow 3D Gate All Around Devices"</p> <p>10:10-10:30 9a-A03OA S.-W. Cho (Korea Ajou University) "Effect of CH₂F₂ Addition on the Angular Dependence of Si₃N₄ Etch Rates and SiO₂-to-Si₃N₄ Etch Selectivity in a C₄F₆/Ar/O₂ Plasma"</p>			<p>9:20-9:50 基調講演 9a-B01KB Y. Cordier (ORHEA-CNRS, フランス) "Comparison of GaN Based Structures Grown by Molecular Beam Epitaxy Using Nitrogen Plasma and Ammonia Sources"</p> <p>9:50-10:10 9a-B02OB T. Ohachi (Doshisha University) "RF Nitrogen Source for MBE Growth of Group III Nitrides on Si and its Application for AM-MEE"</p> <p>10:10-10:30 9a-B03OB S. Chen (Nagoya University) "Radical Kinetics in N₂-H₂ Plasma Generated by Novel High Density Radical Source"</p>			<p>9:20-9:50 基調講演 9a-C01KC 権住 俊一 (大阪大学) "Nanomaterials for Artificial Photosynthesis"</p> <p>9:50-10:10 招待講演 9a-C02IC 吉田 司 (岐阜大学) "Electrochemical Self-Assembly of Nanostructured ZnO/Dye Hybrid Thin Films for Solar Cells"</p> <p>10:10-10:30 9a-C03OC S. Adhikari (Chubu University) "Both Single Walled and Multi Walled Carbon Nanotubes Incorporated Organic Solar Cells"</p>			<p>9:20-9:50 基調講演 10a-A01KA R. d'Agostino (パリ大学, イタリア) "Plasma Nano-structured Fluorinated-Polymers"</p> <p>9:50-10:10 基調講演 10a-A02KA U. R. Kortshagen (ミネソタ大学, アメリカ) "Plasma-Synthesized Silicon Nanocrystals for Photovoltaics"</p> <p>10:20-10:40 招待講演 10a-A03IA 吉田 豊信 (東京大学) "Toward a Direct Production of Wafer-equivalent Si Films by Mesoplasma CVD"</p>			<p>9:20-9:50 基調講演 10a-B01KB 太田 光一 (豊田合成(株)) "History of GaN LEDs and Their Progress"</p> <p>9:50-10:10 招待講演 10a-B02IB V. Haerle (OSRAM, ドイツ) "LED-Technology Enabling New Applications"</p> <p>10:20-10:30 10a-B03OB C.-C. Kao (National Cheng Kung University) "Localized Surface Plasmon-Enhanced GaN-based Light-Emitting-Diode with Ag Nanotriangles Array by Nanosphere Lithography"</p>			<p>9:20-9:50 基調講演 10a-C01KC L. A. Rocha (ミーニョ大学, ポルトガル) "Functionalization of Ti Surfaces for Biomedical Applications"</p> <p>9:50-10:10 10a-C02OC E. Miura-Fujiwara (Nagoya Institute of Technology) "Fabrication of Metal-based Functionally Graded Grinding Wheel Dispersing Fine Ceramic Particles by a Centrifugal Mixed-powder Method"</p> <p>10:10-10:30 10a-C03OC M. Tokita (Bits Company Limited) "Development of Industrial Products on Functionally Graded Materials by Spark Plasma Sintering (SPS) Method"</p>			
	(10:15-10:35) 休憩			(10:30-10:50) 休憩			(10:40-10:50) 休憩			(10:30-10:50) 休憩									
	<p>知的東長クハラ野田正治(ASCTF) 創成事業(第二期) (A会場)</p> <p>10:35-11:00 知的クラスター講演 8a-A02C 堀 勝 (名古屋大学) "Fundamental Research on Plasma Nanoprocessing"</p> <p>11:00-11:15 知的クラスター講演 8a-A03C 天野 浩 (名城大学) "Research on the Nitride-Based Light Emitters in Tokai Knowledge-Based Cluster"</p> <p>11:15-11:30 知的クラスター講演 8a-A04C 江川 孝志 (名古屋工業大学) "Growth and Device Application of GaN on Si"</p> <p>11:30-11:45 知的クラスター講演 8a-A05C 高井 治 (名古屋大学) "Progress in Solution Plasma Processing"</p> <p>11:45-12:00 知的クラスター講演 8a-A06C 渡辺 義見 (名古屋工業大学) "Improvement of Machining Technologies for CFRP and Difficult-to-Machine Materials in the Transportation Industries"</p>	<p>10:50-11:20 基調講演 9a-A04KA J. P. Chang (カリフォルニア大学, アメリカ) "Multifunctional Oxide Materials: Synthesis and Patterning"</p> <p>11:20-11:40 9a-A05OA T. Kachi (Toyota Central R&D Labs., Inc.) "Suppression of Leakage Current Through the pn Junction Fabricated on Etched Surfaces of GaN"</p> <p>11:40-12:00 9a-A06OA C. S. Moon (Nagoya University) "A Well-Established Compact Combinatorial Etching Process Employing Inductively Coupled H₂/N₂ Plasma"</p>			<p>10:50-11:20 基調講演 9a-B04KB B. Daudin (CEA グルノーブル研究所, フランス) "Growth, Structural and Optical Properties of GaN/AlN Nanowire Heterostructures"</p> <p>11:20-11:40 9a-B05OB H. Umeda (Ritsumeikan University) "Fabrication of InN/InGaN Multi Quantum Well Structures by Droplet Elimination by Radical-beam Irradiation"</p> <p>11:40-12:00 9a-B06OB J. L. Guyaux (RIBER SA) "Current and Future's Development of Thinfilm Technology"</p>			<p>10:50-11:20 基調講演 9a-C04KC J. Patscheider (EMPA, スイス) "Hard and Optically Transparent Al-Si-N Thin Films: Solid Solutions, Nanocomposites and Nanomultilayers"</p> <p>11:20-11:40 招待講演 9a-C05IC 駒 益弘 (上智大学) "Mulch Layer Deposition of Silica Films on Polycarbonate by Combining Atmospheric Pressure Glow Plasma and Sol-Gel Method"</p> <p>11:40-12:00 9a-C06OC Y. Musil (University of West Bohemia) "Hard Nanocomposite Coatings: Mechanical and Tribological Properties, Thermal Stability and Protection against Oxidation above 1000-C"</p>			<p>10:50-11:20 基調講演 10a-A04KA 高本 達也 (シャープ(株)) "High Efficiency Multijunction Solar Cells"</p> <p>11:20-11:40 10a-A05OA M. Umeno (Chubu University) "Synthesis of Carbon Thin Film for Solar Cells Application"</p> <p>11:40-12:00 10a-A06OA Y. Kawashima (Kyushu University) "Synthesis of Crystalline Si Nanoparticles for Quantum Dots Sensitized Solar Cells"</p>			<p>10:50-11:20 基調講演 10a-B04KB C. J. Sun (ITRI, 台湾) "UV WLED for Wide Color Gamut Display Application"</p> <p>11:20-11:40 10a-B05OB Y. Sakai (Nagoya Institute of Technology) "MOCVD Growth and Characterization of AlInN-based Schottky Ultraviolet Photodiodes on AlN Template"</p> <p>11:40-12:00 10a-B06OB F. Matsuno (Toyohashi University of Technology) "Intelligent UV Sensor Composed of GaN-based Photodiode and Si-charge Transfer Type Signal Processor"</p>			<p>10:50-11:20 基調講演 10a-C04KC P. Milani (ミラノ大学, イタリア) "Pulsed Microplasma Cluster Source: A Powerful Tool for the Integration of Nanomaterials on Microdevices"</p> <p>11:20-11:40 10a-C05OC K. Sumiyama (Nagoya Institute of Technology) "Fe-Si Core/Shell Clusters Prepared by Collisions of Fe and Si Clusters in a Plasma-Gas-Condensation System"</p> <p>11:40-12:00 10a-C06OC H. Miyata (Kyushu University) "Control of Surface Roughness of Nano-particle Composite Low-k Film Deposited in CVD Plasma"</p>		
		(12:00-13:00) ランチ			(12:00-13:00) ランチ			(12:00-13:00) ランチ											
		(13:00-14:30) ポスターセッション A			(13:00-14:30) ポスターセッション B			(13:00-14:30) ポスターセッション B											
<p>ブ産ラズマ①(中野大学)</p> <p>14:30-15:00 基調講演 8p-A01KA U. Ozarnetzki (ルーレル大学ポツダム校, ドイツ) "The Optical Probe: A Novel Device for Spatially Resolved Optical Emission Spectroscopy in Plasmas"</p> <p>15:00-15:20 8p-A02OA K. Urabe (Kyoto University) "Spatial Distribution of Electron Density in a Parallel-plate Dielectric Barrier Discharge Measured by CO₂-laser Heterodyne Interferometry"</p> <p>15:20-15:40 8p-A03OA C. Koshimizu (TOKYO ELECTRON AT LTD.) "Temperature Measurement of Silicon Wafer in Plasma Etching Process Using Low-coherence Interferometry"</p> <p>15:40-16:00 8p-A04OA Q. Zhang (Chubu University) "Plasma Electron Monitoring with Multi-Resonator Frequency Shift Probe"</p>		<p>窒産化ロ物：I ①Nザン電子デバイス(名古屋大学、B会場)</p> <p>14:30-14:50 招待講演 8p-B01IB S. Arulkumar (ナンヤン工科大学, シンガポール) "High Performance AlGaIn/GaN High-Electron-Mobility Transistors on Silicon Substrate"</p> <p>14:50-15:10 招待講演 8p-B02IB 橋詰 保 (北海道大学) "Effects of Plasma Processing on Surface Properties of GaN and AlGaIn"</p> <p>15:10-15:30 8p-B03OB S. Nakamura (Tokyo Metropolitan University) "Electrical and Optical Characterization of Plasma-Induced Defects in n-type GaN Exposed to Plasma"</p> <p>15:30-15:50 8p-B04OB S. L. Selvaraj (Nagoya Institute of Technology) "Improved Breakdown by Suppressing Gate Leakage Using 2nm i-GaN Cap Layered AlGaIn/GaN HEMTs on Silicon"</p>	<p>ナ産ノ材：②松本功N(大成) ③長尾(日酸) ④M(株) ⑤C(株)</p> <p>14:30-15:00 基調講演 8p-C01KC J. Robertson (ケンブリッジ大学, イギリス) "Plasma Deposition of Amorphous Diamond-like Carbon Films"</p> <p>15:00-15:20 依頼講演 8p-C02TC H. Ohara (Nippon ITF Inc.) "Industrial Applications of DLC and their Scientific Aspects"</p> <p>15:20-15:40 依頼講演 8p-C03TC M. Hasegawa (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) "Low Temperature Nano-crystalline Diamond Film Synthesis Using Surface Wave Plasma Chemical Vapor Deposition"</p> <p>15:40-16:00 依頼講演 8p-C04TC H. Yamada (AIST) "A Description of Reactive Microwave-plasma-CVD of Single-crystal-diamond"</p>	<p>窒産化ロ物：⑤吉川 ⑥川明彦(千葉大学) ⑦千原(千原) ⑧千原(千原) ⑨千原(千原) ⑩千原(千原) ⑪千原(千原) ⑫千原(千原) ⑬千原(千原) ⑭千原(千原) ⑮千原(千原) ⑯千原(千原) ⑰千原(千原) ⑱千原(千原) ⑲千原(千原) ⑳千原(千原) ㉑千原(千原) ㉒千原(千原) ㉓千原(千原) ㉔千原(千原) ㉕千原(千原) ㉖千原(千原) ㉗千原(千原) ㉘千原(千原) ㉙千原(千原) ㉚千原(千原) ㉛千原(千原) ㉜千原(千原) ㉝千原(千原) ㉞千原(千原) ㉟千原(千原) ㊱千原(千原) ㊲千原(千原) ㊳千原(千原) ㊴千原(千原) ㊵千原(千原) ㊶千原(千原) ㊷千原(千原) ㊸千原(千原) ㊹千原(千原) ㊺千原(千原) ㊻千原(千原) ㊼千原(千原) ㊽千原(千原) ㊾千原(千原) ㊿千原(千原)</p>	<p>14:30-15:00 基調講演 9p-A01KB 野田 進 (京都大学) "Photonic Crystals and Their Application to Wide Bandgap Materials (GaN, SiC)"</p> <p>15:00-15:30 基調講演 9p-A02KB N. Grandjean (ローザンヌ工科大学, スイス) "Polariton Condensation Effects in GaN Microcavities"</p> <p>15:30-16:00 基調講演 9p-A03KB ※諸般の事情によりまして、演者が変更となりました。 U. Mishra (UC Santa Barbara, USA) "The Use of Plasma in the Growth and the Processing of Gallium Nitride Materials" ⇒吉川明彦(千原大学) "Recent Advances in Plasma-assisted MBE of 1ML-InN/GaN-matrix Nanostructures for Novel Solar Cell and Light Emitters"</p> <p>16:00-16:20 招待講演 9p-A04IB 上杉 勉 (豊田中央研究所) "GaN Power Switching Devices for Automotive Applications"</p>	<p>ブ産ラズマ⑦(中野大学)</p> <p>14:30-15:00 基調講演 10p-A01KA 東 哲郎 (東京エレクトロン(株)) "Global Competitive Strength by Core Technology" 「コア技術を国際競争力に結びつけるために」</p> <p>15:00-15:30 基調講演 10p-A02KA J. G. Han (成均館大学, 韓国) "Synthesis of Functional Hybrid Films on Polymer by Dual RF Plasma CVD"</p> <p>15:30-16:00 基調講演 10p-A03KA E. Schultheiss (フ라운ホーファー研究所, ドイツ) "Technology Transfer in Germany: the Fraunhofer Model"</p> <p>16:00-16:30 基調講演 10p-A04KA 泉谷 渉 ((株)産業タイムズ社) "Environmental Energy Technology is the Detonator of the Second Industrial Revolution."</p>													
							(16:00-16:20) 休憩			(16:20-16:40) 休憩			(16:30-16:50) 休憩						
	<p>ブ産ラズマ②(山田) ③山田(山田) ④山田(山田) ⑤山田(山田) ⑥山田(山田) ⑦山田(山田) ⑧山田(山田) ⑨山田(山田) ⑩山田(山田) ⑪山田(山田) ⑫山田(山田) ⑬山田(山田) ⑭山田(山田) ⑮山田(山田) ⑯山田(山田) ⑰山田(山田) ⑱山田(山田) ⑲山田(山田) ⑳山田(山田) ㉑山田(山田) ㉒山田(山田) ㉓山田(山田) ㉔山田(山田) ㉕山田(山田) ㉖山田(山田) ㉗山田(山田) ㉘山田(山田) ㉙山田(山田) ㉚山田(山田) ㉛山田(山田) ㉜山田(山田) ㉝山田(山田) ㉞山田(山田) ㉟山田(山田) ㊱山田(山田) ㊲山田(山田) ㊳山田(山田) ㊴山田(山田) ㊵山田(山田) ㊶山田(山田) ㊷山田(山田) ㊸山田(山田) ㊹山田(山田) ㊺山田(山田) ㊻山田(山田) ㊼山田(山田) ㊽山田(山田) ㊾山田(山田) ㊿山田(山田)</p>						<p>窒産化ロ物：①福田(東北) ②松本(松本) ③長尾(日酸) ④M(株) ⑤C(株)</p> <p>16:20-16:50 基調講演 8p-B05KB 福田 永生 (東北大学) "Prospects for the Acidic Ammonothermal Growth of GaN Crystal"</p> <p>16:50-17:10 8p-B06OB H. Y. Geng (FURUKAWA CO., LTD) "Residual Strain Evaluation by Cross-sectional Micro-reflectance Spectroscopy of Freestanding GaN Grown by HVPE"</p> <p>17:10-17:30 8p-B07OB D. Iida (Meijo University) "Growth of GaInN Films by Raised Pressure MOVPE System at 200kPa"</p>	<p>ナ産ノ材：①若原(若原) ②先(先) ③先(先) ④先(先) ⑤先(先) ⑥先(先) ⑦先(先) ⑧先(先) ⑨先(先) ⑩先(先) ⑪先(先) ⑫先(先) ⑬先(先) ⑭先(先) ⑮先(先) ⑯先(先) ⑰先(先) ⑱先(先) ⑲先(先) ⑳先(先) ㉑先(先) ㉒先(先) ㉓先(先) ㉔先(先) ㉕先(先) ㉖先(先) ㉗先(先) ㉘先(先) ㉙先(先) ㉚先(先) ㉛先(先) ㉜先(先) ㉝先(先) ㉞先(先) ㉟先(先) ㊱先(先) ㊲先(先) ㊳先(先) ㊴先(先) ㊵先(先) ㊶先(先) ㊷先(先) ㊸先(先) ㊹先(先) ㊺先(先) ㊻先(先) ㊼先(先) ㊽先(先) ㊾先(先) ㊿先(先)</p>	<p>窒産化ロ物：①若原(若原) ②先(先) ③先(先) ④先(先) ⑤先(先) ⑥先(先) ⑦先(先) ⑧先(先) ⑨先(先) ⑩先(先) ⑪先(先) ⑫先(先) ⑬先(先) ⑭先(先) ⑮先(先) ⑯先(先) ⑰先(先) ⑱先(先) ⑲先(先) ⑳先(先) ㉑先(先) ㉒先(先) ㉓先(先) ㉔先(先) ㉕先(先) ㉖先(先) ㉗先(先) ㉘先(先) ㉙先(先) ㉚先(先) ㉛先(先) ㉜先(先) ㉝先(先) ㉞先(先) ㉟先(先) ㊱先(先) ㊲先(先) ㊳先(先) ㊴先(先) ㊵先(先) ㊶先(先) ㊷先(先) ㊸先(先) ㊹先(先) ㊺先(先) ㊻先(先) ㊼先(先) ㊽先(先) ㊾先(先) ㊿先(先)</p>	<p>16:40-18:10 パネルディスカッション ~Application of Advanced Plasma Technology for Nitride Semiconductors~ <モデレーター> 名西 徳之 (立命館大学) <パネリスト> 天野 浩 (名城大学) B. Daudin (CEA グルノーブル原子力研究所, フランス) N. Grandjean (ローザンヌ工科大学, スイス) 橋詰 保 (北海道大学) 加納 浩之 (NUエコエンジニアリング 株式会社) 奥村 次徳 (首都大学東京)</p>									
											(17:00-18:00) 受付			(18:10-19:40) パンケット(名城大学 名城食堂)			(18:20-18:30) 閉会の辞		
											(18:00-19:30) ウェルカムパーティー(名城大学 学生ホール)			(17:30-19:00) ポスターセッション A			(18:20-18:30) 閉会の辞		